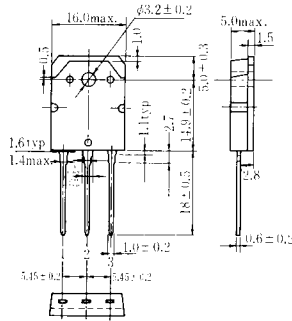


2SD1496

コン NPN 三重拡散形
高圧電力スイッチング用
水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

(TO-3P)

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	目	Symbol	2SD1496	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CE0}	600	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EB0}	6	V
コレクタ電流		I_C	5	A
ピークコレクタ電流		$I_{C(surge)}$	16	A
許容コレクタ損失		P_C^*	50	W
許容コレクタ損失		P_C^{**}	20	W
結晶部温度		T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-45 ~ +150	$^\circ\text{C}$

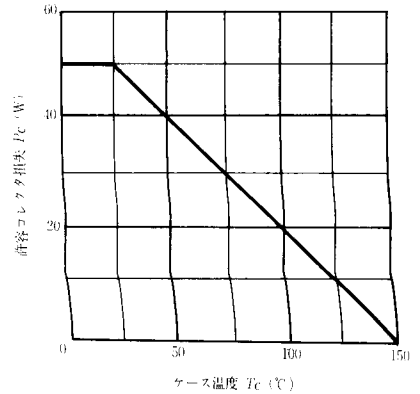
* $T_a=25^\circ\text{C}$ における許容値。

** シリコンオイルを塗布した付属のマイカ板を介して放熱板(200mm×300mm×1.5mmアルミ板)に取付けた時の許容値。

*** Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

**** Value when attach on the heat sink plate (200mm×300mm×1.5mm Al)

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	500	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBX}	$V_{CB}=1500\text{V}, V_{EB}=1.5\text{V}$	—	—	1	mA
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=4.5\text{A}, I_B=1.2\text{A}$	—	—	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C=4.5\text{A}, I_B=1.2\text{A}$	—	—	1.5	V
下降時間		t_f	$I_C=3\text{A}, I_{B1}\cong 0.7\text{A}, I_{B2}\cong -2.7\text{A}, L_B=0$	—	—	2.3	μs

This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.